

В СПбО РАН состоялся VIII симпозиум «Полупроводниковые лазеры: физика и технология»

15.04.2025

В историческом здании Императорской академии наук на Университетской набережной состоялся VIII симпозиум «Полупроводниковые лазеры: физика и технология», посвященный 95-летию со дня рождения Нобелевского лауреата **Ж.И. Алферова** и памяти выдающегося ученого-физика, внесшего огромный вклад в развитие физики полупроводников, академика **Р.А. Суриса**.

Идея создания научного мероприятия принадлежала академику **Ж.И. Алферову** (1930-2019), который являлся его бессменным председателем.

Организаторы – Санкт-Петербургское отделение РАН и Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН.

Участие приняли 140 ученых из ведущих научных учреждений РФ, занимающиеся фундаментальными и прикладными исследованиями в области получения и исследования светоизлучающих полупроводниковых соединений и структур, из Санкт-Петербурга, Москвы, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Воронежа, Саратова, Обнинска и др.

На пленарном заседании обсудили состояние и проблемы современной нано-оптоэлектроники, определили приоритетные направления развития полупроводниковых лазеров и перспективы их внедрения.

Ученые отметили важность фундаментальных и прикладных исследований светоизлучающих полупроводниковых соединений и структур с целью создания самых современных лазеров и обозначили необходимость активного взаимодействия науки, производства и бизнеса для дальнейшего развития российской физики полупроводников.

Одна из главных задач симпозиума – вовлечение в активную научную работу молодых ученых. За лучшие доклады исследователям до 36 лет были вручены премии: А.А. Разовой (ИФМ РАН, Нижний Новгород) за доклад «Микролазеры инфракрасного диапазона на основе гетероструктур с квантовыми ямами HgCdTe/CdHgTe » и П.С. Гавриной (ФТИ им. А.Ф. Иоффе, Санкт-Петербург) за «Влияние длины резонатора на уровень пиковой мощности лазеров-тиристоров при генерации импульсов длительностью единицы наносекунд».







